

## DÜNNE SCHICHTEN (DS)

Prof. Dr. Bernd Rauschenbach  
 Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung  
 Permoserstr. 15  
 04318 Leipzig  
 E-Mail: bernd.rauschenbach@iom-leipzig.de

### ÜBERSICHT DER HAUPTVORTRÄGE UND FACHSITZUNGEN (Hörsäle TU H107, TU H110)

#### Hauptvorträge

DS 1.1	Fr	10:00	(TU H107)	<b>Not so amorphous silicon dioxide films on silicon</b> , Wolfgang Donner, M. Castro-Colin, S.C. Moss, Z. Islam, S.K. Sinha, R. Nemanich, H.T. Metzger, P. Boesecke, T. Schuelli
DS 3.1	Fr	12:00	(TU H107)	<b>X-ray absorption studies of hard coatings in the boron-carbon-nitrogen</b> , R. Gago, I. Jimenez
DS 6.1	Fr	14:00	(TU H110)	<b>Strukturierung von dünnen Schichtsystemen auf EUV Photolithographiemasken</b> , Jan Hendrik Peters
DS 7.1	Sa	13:45	(TU H107)	The role of ion irradiation induced viscous flow in thin film structuring: Hard matter going soft, S.G. Mayr
DS 9.1	Sa	09:00	(TU EB301)	Low-dimensional electrons at silicon surfaces, Franz J. Himpsel
DS 12.1	Mo	10:45	(TU H107)	Solid matter under extreme conditions - Electronic excitations by swift highly charged ions, Gregor Schiwietz
DS 15.1	Mo	09:45	(TU EB301)	Femtosecond dynamics of adsorbate-surface interactions studied by means of time-resolved photoelectron spectroscopy, Vortrag des Gaede-Preisträgers Michael Bauer
DS 17.1	Mo	13:30	(TU H110)	Mechanisms of mechanical deformation in artificial superlattices and self-organized nanostructured thin films, Lars Hultman
DS 19.1	Di	13:45	(TU H107)	In-situ-Charakterisierung der Schichtabscheidung mit gepulsten Magnetrons, Thomas Welzel

#### FV-internes Symposium „Anorganische Dielektrika für die künftige Mikro- und Nanotechnologie“

DS 10.1	Sa	10:00	(TU H110)	Atomic-scale properties of high-k dielectrics for CMOS: ab initio study for Pr-based materials, Jarek Dabrowski, Andrzej Fleszar
DS 10.2	Sa	10:45	(TU H110)	Epitaxial growth of oxide layers on silicon surfaces, Wolfgang Moritz, Nicole Jeutter, Laure Libralesso, Jörg Zegenhagen
DS 10.3	Sa	11:30	(TU H110)	The role of interfaces in nanosize ferroelectrics oxides, Marin Alexe, Lucian Pintilie, Dietrich Hesse
DS 10.4	Sa	12:15	(TU H110)	DRAM capacitor scaling, M. Gutsche, T Hecht, S Jakschik, C Kapteyn, G Krautheim, S Kudelka, J Lützen, A Sänger, U Schröder, H Seidl, A Avellan, J Heitmann, G Hirt
DS 10.5	Sa	13:00	(TU H110)	Advance MOSFET gate dielectrics for high-performance microprocessors: Materials selection and analytical challenges, E. Zschech, H.-J. Engelmann, K. K Dittmar, S. Ohsiek, B. Tracy, E. Adem, A. Myers, S. Robie, M. Sidorov, J. Bernard

**FV-internes Symposium „Optische Spektroskopie von dünnen Schichten und Grenzflächen“**

DS 21.1	Di	09:45	(TU H110)	Real-time optical diagnostics for epitaxial growth, <u>D. E. Aspnes</u>
DS 21.2	Di	10:30	(TU H110)	Ab-initio calculations of electronic and optical properties of surfaces, <u>Olivia Pulci</u>
DS 21.3	Di	11:15	(TU H110)	Optical analysis of monolayers at surfaces and interfaces, <u>V. Wagner</u>
DS 21.4	Di	12:00	(TU H110)	Biomolecular layers on silicon studied by optical spectroscopy, <u>Dietrich R.T. Zahn</u>
DS 21.5	Di	12:45	(TU H110)	Infrared ellipsometry for structure analysis of organic films, <u>Karsten Hinrichs</u> , Michael Gensch, Katy Roodenko, Norbert Esser

**Fachsitzungen**

DS 1	<b>Dünnschichtanalytik I</b>	Fr	10:00–10:45	TU H107	DS 1.1–1.1
DS 2	<b>Elektrische und optische Schichteigenschaften</b>	Fr	10:45–12:00	TU H107	DS 2.1–2.5
DS 3	<b>Dünnschichtanalytik II</b>	Fr	12:00–12:45	TU H107	DS 3.1–3.1
DS 4	<b>Halbleitende, amorphe und organische Schichten</b>	Fr	14:45–15:45	TU H107	DS 4.1–4.4
DS 5	<b>Optische, metallische und magnetische Schichten</b>	Fr	10:45–12:00	TU H110	DS 5.1–5.5
DS 6	<b>Anwendung dünner Schichten</b>	Fr	14:00–15:45	TU H110	DS 6.1–6.5
DS 7	<b>Ionenstrahlverfahren I</b>	Sa	13:45–15:00	TU H107	DS 7.1–7.3
DS 8	<b>Ionen-Festkörper-Wechselwirkung I</b>	Sa	15:15–17:00	TU H107	DS 8.1–8.7
DS 9	<b>Elektronische Eigenschaften von Oberflächen</b>	Sa	09:00–09:45	TU EB301	DS 9.1–9.1
DS 10	<b>FV-internes Symposium „Anorganische Dielektrika für die künftige Mikro- und Nanotechnologie“</b>	Sa	10:00–13:45	TU H110	DS 10.1–10.5
DS 11	<b>Anorganische dielektrische Schichten</b>	Sa	14:30–15:45	TU H110	DS 11.1–11.5
DS 12	<b>Ionen-Festkörper-Wechselwirkung II</b>	Mo	10:45–12:45	TU H107	DS 12.1–12.6
DS 13	<b>Ionenstrahlverfahren II</b>	Mo	14:15–15:15	TU H107	DS 13.1–13.4
DS 14	<b>Schichtherstellung mit Laserverfahren</b>	Mo	15:15–16:45	TU H107	DS 14.1–14.6
DS 15	<b>Vortrag des Gaede-Preisträgers</b>	Mo	09:45–10:30	TU EB301	DS 15.1–15.1
DS 16	<b>Dünnschichtanalytik III</b>	Mo	10:45–13:00	TU H110	DS 16.1–16.9
DS 17	<b>Harte Schichten und mechanische Eigenschaften</b>	Mo	13:30–15:15	TU H110	DS 17.1–17.5
DS 18	<b>Optische Spektroskopie dünner Schichten I</b>	Mo	15:15–16:45	TU H110	DS 18.1–18.6
DS 19	<b>Schichtabscheidung</b>	Di	13:45–15:15	TU H107	DS 19.1–19.4
DS 20	<b>Schichtwachstum</b>	Di	15:15–16:30	TU H107	DS 20.1–20.5
DS 21	<b>FV-internes Symposium „Optische Spektroskopie von dünnen Schichten und Grenzflächen“</b>	Di	09:45–13:30	TU H110	DS 21.1–21.5
DS 22	<b>Optische Spektroskopie dünner Schichten II</b>	Di	14:30–16:45	TU H110	DS 22.1–22.9
DS 23	<b>Postersitzung I</b>	Fr	16:00–18:30	Poster TU B	DS 23.1–23.47
DS 24	<b>Postersitzung II</b>	Di	17:00–19:00	Poster TU B	DS 24.1–24.27

**FV-übergreifende Symposien**

- **Highlights in Synchrotron Radiation Research**, Sa, TU H3010, Details siehe SYSR
- **From quantisation in the gravitational field to correlated electron systems: Perspectives of research with neutrons**, Di, TU HE101, Details siehe SYRN
- **Nichtflüchtige Festkörperspeicher**, Sa, TU HE101, Details siehe SYFS
- **Organic Optoelectronics and Photonics**, Mo, TU HE101, Details siehe SYOO
- **Symposium des FV Oberflächenphysik "Recent Progress in Scanning Probe Methods"**, Fr, 11:00, TU H3005

**Mitgliederversammlung des Fachverbands Dünne Schichten**

Mo 17:00–17:30    TU H107

Tagesordnung:

1. Bericht des Sprechers
2. Symposien und Hauptvorträge 2006
3. Verschiedenes

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Fachverbandes findet um 17:30 Uhr im H 107 der TU die Mitgliederversammlung der Deutschen Vakuumgesellschaft statt.

**Hinweis**

Die Postersitzungen DS 23 am Freitag von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr und DS 24 am Dienstag von 17:00 bis 19:00 Uhr finden im Bereich vor dem Hörsaal H 107 im Hauptgebäude der TU Berlin statt.

Die Poster sollten ab 8:00 Uhr aufgehängt und erst nach der Postersitzung wieder entfernt werden.